

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年3月17日(2005.3.17)

【公開番号】特開2002-110973(P2002-110973A)

【公開日】平成14年4月12日(2002.4.12)

【出願番号】特願2000-299546(P2000-299546)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 29/78

H 01 L 21/316

H 01 L 21/318

H 01 L 21/8238

H 01 L 27/092

【F I】

H 01 L 29/78 301 G

H 01 L 21/316 S

H 01 L 21/316 M

H 01 L 21/318 M

H 01 L 21/318 C

H 01 L 27/08 321 D

【手続補正書】

【提出日】平成16年4月12日(2004.4.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0021

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0021】

引き続き図1(d)に示すように、前記ゲート電極膜4(a)をパターニングし、エッチング除去によりトランジスタのゲート電極膜4(b)を形成し、以下公知の技術により、トランジスタのソース/ドレイン5、層間絶縁膜6、コンタクトホール7、およびメタル配線8を形成してMOSトランジスタを製造する。